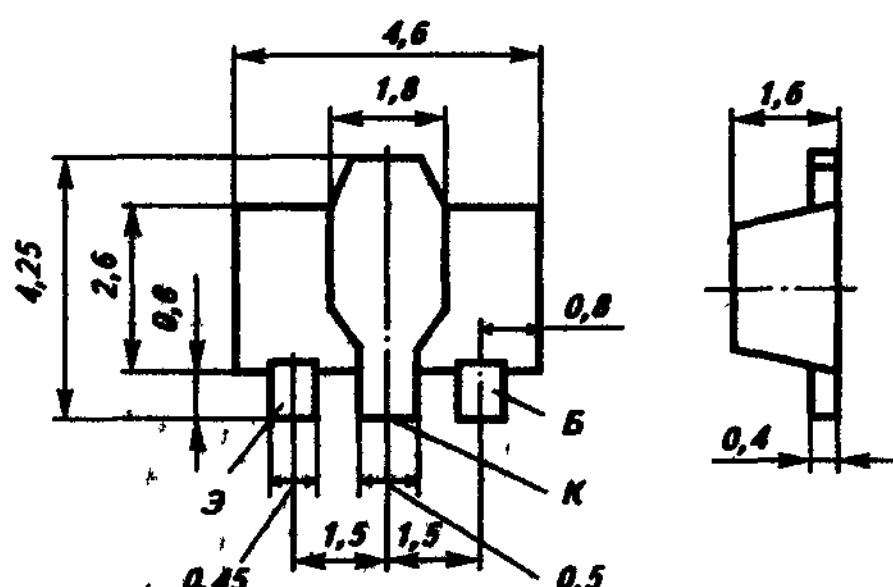


□ 2T665A9, 2T665B9



2T665(A9,B9)

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $n-p-n$ универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Маркируются условными знаками: 2T665A9-2A, 2T665B9-2Б. Масса транзисторов не более 0,1 г.

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 2$ В, $I_{\Theta} = 0,15$ А	40...250
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{\Theta} = 50$ мА, типовое значение	200* МГц

Граничное напряжение при $I_{\Theta} = 30$ мА, не менее:

2T665A9	80 В
2T665B9	60 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_K = 0,15$ А, $I_B = 15$ мА,
не более

0,3 В

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_K = 0,15$ А, $I_B = 15$ мА,
не более

1,1 В

Время включения при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_K = 0,2$ А, $I_B = 40$ мА, не более

0,1 мкс

Время выключения при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_K = 0,2$ А, $I_B = 40$ мА, не более

0,5 мкс

Время спада при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_K = 0,2$ А, $I_B = 40$ мА, не более

0,2 мкс

Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, не более

25 пФ

Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, не более

150 пФ

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 100$ В, не более

10 мКА

Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5$ В, не более

10 мКА

Пределные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:

2T665A9	120 В
2T665B9	100 В

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:

при $R_{БЭ} = 1$ кОм:

2T665A9	100 В
2T665B9	80 В

при $R_{БЭ} = \infty$:

2T665A9	80 В
2T665B9	60 В

Постоянное напряжение эмиттер-база

5 В

Постоянный ток коллектора

1 А

Импульсный ток коллектора при $t_H = 10$ мс

1,5 А

Постоянный ток базы

0,3 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = -60...+25^{\circ}\text{C}$:

с теплоотводом	1 Вт
без теплоотвода	0,3 Вт

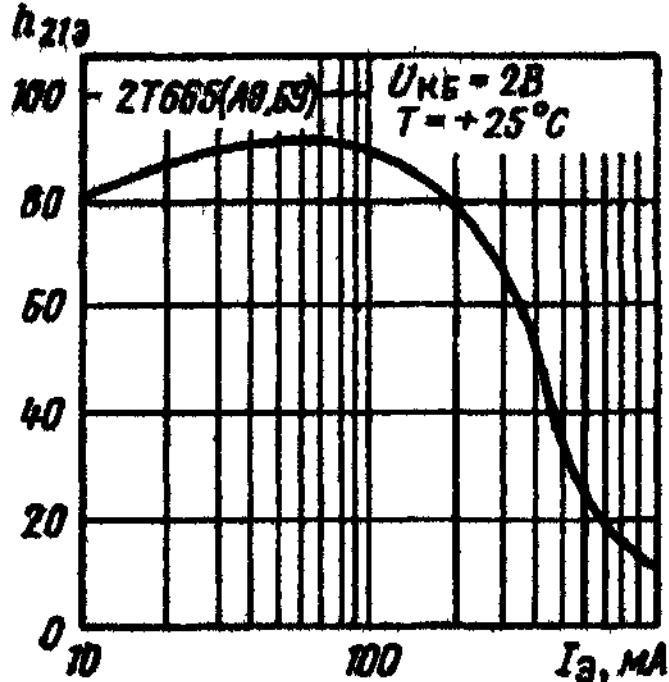
Температура $p-n$ перехода

+150°C

Температура окружающей среды

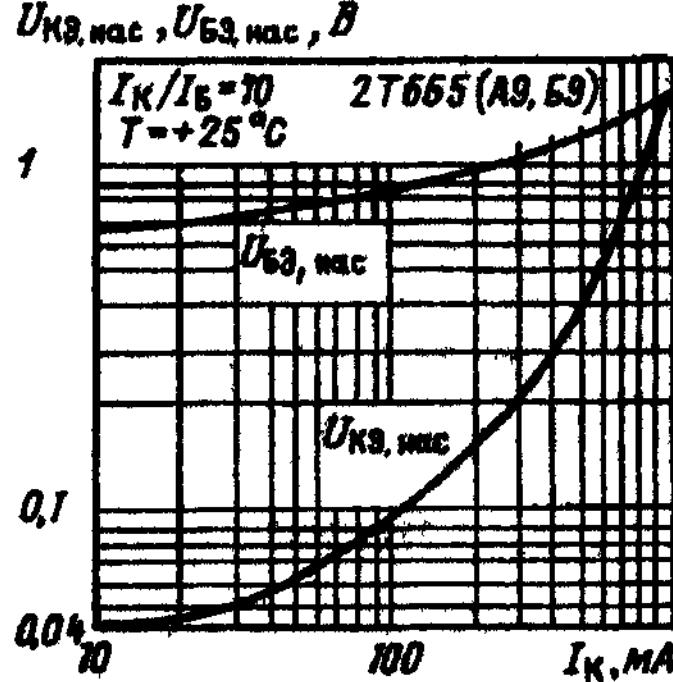
-60°C... $T_K = +100^{\circ}\text{C}$

b_{213}



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера

$U_{КЭ,нас}, U_{БЭ,нас}, В$



Зависимости напряжений насыщения коллектор-эмиттер и база-эмиттер от тока коллектора.